

特点

- 高电容已经通过精密技实现
奥希斯，允许使用多个较薄的陶瓷电介质层。
- 单片结构保证了优异的机械强度和可靠性。
- 高精度自动安装是通过促进
保养的非常精确的尺寸公差。
- 由唯一的陶瓷和金属，这些电容亲
韦迪极为可靠的性能，表现几乎没有
甚至当经受极端温度降解。
- 低杂散电容确保了高符合标称val-
的UE，从而简化了电路设计过程。
- 低残留电感，保证了优异的频率特性。

产品标识

C 1005 CH 1H 100天 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 系列名称

(2) 尺寸L W

0603	0.6 0.3mm
1005	1.0 0.5mm
1608	1.6 0.8mm
2012	2.0 1.25mm
3216	3.2 1.6mm

(3) 电容温度特性

第1类 (温度补偿)

温度特征	静电容量变化	温度范围
C0G	0±30ppm/°C	-55到+ 125°C

第2类 (温度稳定, 通用)

温度特征	静电容量变化	温度范围
X7R	±15%	-55到+ 125°C
X5R	±15%	-55至+ 85°C
Y5V	+22, -82%	-30至+ 85°C

(4) 额定电压Edc

0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1H	50V

(5) 额定容量

的电容被表示在3位代码，并在单位
微微法拉 (pF) 的。

所述第一和第二位数字标识，第一和第二显著
的电容的数字。

第三个数字标识的乘数。

R表示小数点。

010	1pF
100	10pF
102	1000pF
0R5	0.5pF

(6) 电容公差

符号	公差	适用电容范围
C	±0.25pF	在10pF以下
D	±0.5pF	
J	±5%	在10pF的
K	±10%	
M	±20%	
Z	+80, -20%	

(7) 包装形式

T	编带 (卷)
B	体积

